

О влиянии магнитного поля на ионизацию атомов

Попов В. С., Сергеев А. В.

Аннотация


В квазиклассическом приближении вычислена вероятность ионизации атомного уровня под действием постоянных электрического и магнитного полей, с учетом кулоновского взаимодействия между вылетающим электроном и атомным остатком. Рассмотрена структура рядов теории возмущений (ТВ) для энергии уровня и найдена асимптотика высших порядков ТВ. В расчетах используется метод “мнимого времени”, развитый ранее в теории многофотонной ионизации атомов и ионов.

§1. Введение

Задача об атоме водорода во внешних электромагнитных полях имеет фундаментальное значение для атомной физики, ей посвящена обширная литература (см., например [1 -] и указанные там дальнейшие ссылки). При этом, в большинстве работ рассматриваются несколько первых порядков теории возмущений (ТВ) для энергии уровней. Влияние магнитного поля на ширину уровня, т. е. на вероятность ионизации атома W , изучалось в работах []. Если ограничиться случаем полей, малых по сравнению с характерными внутриатомными полями (см. ниже ()), то ионизация носит туннельный характер, и можно использовать квазиклассическое приближение (метод ВКБ []).

Задачи о прохождении частиц через потенциальный барьер встречаются в различных областях физики и обычно решаются с помощью метода ВКБ. Обобщением его на случай потенциалов $V(x,t)$, зависящих от времени, а также на многомерный случай является ¹⁾ метод "мнимого времени" (ММВ), основной идеей которого является описание подбарьерного движения частицы с помощью классических уравнений движения, но с мнимым "временем".

1) *ÌÏÃ áúë ðàçàèð à ðàíðèè ìííãíðíðííííé èííèçàòèè àðíííâ è èíííâ ìíèãàì ñèèúííé ñãàðíáíé áíèíú [], à ðàèæà á çàãã÷á î ðíæãáíèè ýèàèððíí-ííçèððíííúð ìàð èç ààèóóìà á ìàðáíáííí ýèàèððè÷ãñèí ìíèã []. Íàèáíèãã ìãðíáííâ èçèíæáíèã ÌÏÃ ààíí á ðãáíðà []. Ã [] íí ìðèìáíýññý äèý ìàðíæãáíèý ãñèííðíðèèè áññèè ìðýãèíâ 1/n-ðàçèíæáíèý.*

уровня (всюду далее $\hbar = e = m_e = 1$). При этом отношение Y/T , а также угол между полями могут быть произвольными. Заметим, что для основного состояния параметр α порядка единицы (так, $\alpha = 1$,  соответственно для атомов водорода, гелия, неона и криптона), однако для высоковозбужденных (ридберговских) состояний он может быть меньше единицы (Например, в атоме водорода $\alpha = 1/n$ для состояний с главным квантовым числом n). В этом случае поля, сравнимые с T_0 и Y_0 , значительно меньше атомных и вполне достижимы на эксперименте.

Возможность ионизации означает, что атом находится в квазистационарном состоянии с комплексной энергией $E = E_0 - i\frac{\Gamma}{2}$. Вещественная часть энергии E_0 определяет положение уровня, а вероятность распада Γ — его ширину. Энергия как аналитическая функция напряженности поля T имеет разрез вдоль вещественной оси и существенную особенность при $T = 0$. Последнее обстоятельство приводит к расходимости ряда T^N по степеням T при любых напряженностях поля. Для атома водорода в электрическом поле эта расходимость, как известно [5], связана с экспоненциальным убыванием ширины при $T \rightarrow 0$ и носит факториальный характер. В присутствии магнитного поля высшие порядки T^N могут быть рассмотрены аналогичным образом.

§2. О влиянии магнитного поля на ионизацию атомов

Для вычисления вероятности ионизации $w(T, Y)$ необходимо найти подбарьерную траекторию электрона и вычислить мнимую часть функции действия:

$$w \propto \exp\left\{-\frac{2}{\hbar} \text{Im} S(0, t_0)\right\}, \quad (2.1)$$

где t_0 — начальный (комплексный) момент подбарьерного движения, а $t = 0$ — момент выхода частицы из-под барьера. Можно показать (см. Приложение), что в случае постоянных полей T и Y учет кулоновского взаимодействия электрона с атомным остатком (заряд Z) можно провести по теории возмущений. Поэтому достаточно определить траекторию электрона при $Z = 0$ (т. е. для δ -потенциала), которая находится аналитически. Экстремальная подбарьерная траектория, минимизирующая мнимую часть действия, определяет наиболее вероятный путь туннелирования частицы и находится из классических уравнений движения с граничными условиями:

$$\mathbf{r}(t_0) = 0, \quad \dot{\mathbf{r}}(t_0) = -\mathbf{a}^2, \quad \text{Im} \mathbf{r}(0) = 0. \quad (2.2)$$

Отсылая за подробностями к [], укажем их наглядный смысл. Первые два условия отвечают тому, что электрон в начальный ($t = t_0$) момент находится уже за пределами атома (т. е.

$|V(r_0)| \ll \mathfrak{a}^2$), а искажением волновой функции из-за действия внешних полей \mathbf{T} и \mathbf{Y} еще можно пренебречь ³⁾. Последнее условие означает, что наиболее вероятная (экстремальная) траектория при $t = 0$ становится вещественной и далее описывает движение частицы на бесконечность, уже в классически разрешенной области. Переходя к мнимому “времени” $\tau = i\omega t$, получаем искомую траекторию ⁴⁾:

$$x = i \frac{T}{\omega^2} \left(\tau - \tau_0 \frac{\text{sh} \tau}{\text{sh} \tau_0} \right) \sin \alpha, \quad y = \frac{T}{\omega^2} \cdot \frac{\tau_0}{\text{sh} \tau_0} (\text{ch} \tau - \text{ch} \tau_0) \sin \alpha, \\ z = \frac{T}{2\omega^2} (\tau_0^2 - \tau^2) \cos \alpha. \quad (2.3)$$

$(-\tau_0 \leq \tau \leq 0)$, причем

$$\tau_0^2 - \sin^2 \alpha (\tau_0 \text{cth} \tau_0 - 1)^2 = \gamma^2. \quad (2.4)$$

Здесь $\gamma = \omega / \omega_t$, $\omega = eY / m_e c$ — ларморовская частота, $\omega_t = T / \mathfrak{a}$ — частота туннелирования в электрическом поле \mathbf{T} ; ось z взята вдоль \mathbf{Y} , ось x перпендикулярна к плоскости (\mathbf{T}, \mathbf{Y}) , α — угол между полями \mathbf{T} и \mathbf{Y} . Параметр γ аналогичен параметру

³⁾ Ñòðĭâĭ âĭâĭðÿ, ÿðĕ òñĕĭâĕÿ ħĭĭðââðñòâóðò ĭóĕââĭĭó ðââĕòñó ñĕĕ, ħâÿçüââðÿĕð ÿĕâĕððĭĭ ñ âðĭĭĭÿĭ ĭñòâðĕĭĭ. ĭĭâĭĭ, ĭâĭâĕĭ, ĭĭĕâçâðü, ÷ðĭ ó÷âð ĕĭĭâ÷ĭâĭ ðââĕòñâ ââĕñðâĕÿ ñĕĕ ĭðĕâĭâĕð ĕ ĭĭĭðââĕâĭ ĭĭðÿâĕâ T/T_0 â ĭðââÿĕñĭĭĭâĭðâ, ĕĭðĭðÿĭĕ ĭÿ ĭðâĭââðââââĭ.

⁴⁾ Ýðĕ âÿðâââĭĕÿ ĭĭĕð÷âððñÿ âĭâĕĕðĕ÷âñĕĕĭ ĭðĭâĭĕââĭĕâĭ ĕçââñðĭÿð òĭðĭóĕ âĕÿ ââĕââĭĕÿ çâðÿââĭĭĕ ÷âñðĕöÿ â ĭĭñðĭÿĭÿð ĕ ĭâĭĭðĭâĭÿð ĭĭĕÿð (ñĭ., ĭâĭðĕĭâð, § â []).

Келдыша [], вводимому в теории многофотонной ионизации переменным электрическим полем. Появление такого параметра связано с тем, что в данной задаче имеются две частоты — ω_t и ω , соотношение между которыми может быть произвольным. Заметим, что

$$\gamma = \frac{\alpha Y}{cT} = \left(\frac{I}{I_0} \right)^{1/2} \frac{Y}{Y_a} \left(\frac{T}{T_a} \right)^{-1},$$

где $I = |E_0|$ — энергия связи данного уровня, а $I_0 = 13.6 \text{ eV}$ — потенциал ионизации атома водорода. В дальнейшем рассматриваем основное состояние, поскольку для возбужденных возникают дополнительные осложнения, связанные с вырождением.

Вычисление укороченного действия [] S вдоль подбарьерной траектории (2.3) определяет экспоненциальный множитель в вероятности ионизации:

$$w(T, Y) \propto \exp \left\{ -\frac{2T_0}{3T} g(\gamma, \alpha) \right\}. \tag{2.5}$$

Функция $g(\gamma, \alpha)$ определена формулой (35) статьи []. Используя уравнение (2.4), можно записать ее в более простом виде:

$$g(\gamma, \alpha) = \frac{3}{2} s \left[1 - (s^2 - 1)^{1/2} \frac{\sin \alpha}{\gamma} \right] - \frac{1}{2} s^3 \cos^2 \alpha, \tag{2.6}$$

где $s = \tau_0 / \gamma$. При $\gamma \ll 1$ имеем (см. Приложение)

$$g(\gamma, \alpha) = 1 + \frac{\sin^2 \alpha}{30} \gamma^2 + \left(\frac{\sin^4 \alpha}{216} - \frac{\sin^2 \alpha}{315} \right) \gamma^4 + \left(\frac{11 \sin^6 \alpha}{11664} - \frac{\sin^4 \alpha}{810} + \frac{\sin^2 \alpha}{3150} \right) \gamma^6 + K, \quad (2.6')$$

а в противоположном случае $\gamma \gg 1$ (сильные магнитные поля) эта функция выходит на конечный предел:

$$g(\gamma, \alpha) = |\cos \alpha|^{-1} - \frac{3}{2\gamma} \operatorname{tg}^2 \alpha + O(\gamma^{-2}) \quad (2.6'')$$

(случай $\alpha = \pi / 2$ является особым и обсуждается в Приложении А).
Графики функций $g(\gamma, \alpha)$ для различных углов α представлены на рис. 1. Если $\alpha \neq 0$, то $g(\gamma, \alpha) > 1$, т. е. магнитное поле всегда стабилизирует уровень.

Для учета кулоновского взаимодействия используем процедуру сшивания, вводя точку сшивания r_1 такую, что $\alpha e^{-1} \ll r_1 \ll b$, где b — ширина барьера. При $r \sim r_1$ атомный потенциал в основном уже сводится к кулоновскому, $V(r) \approx -Z/r$, причем $|V(r)| \ll \alpha e^2$. При этом кулоновское взаимодействие слабо искажает подбарьерную

траекторию ⁵⁾, что и позволяет учесть его вклад в действие по теории возмущений:

$$\delta S = -i\eta \ln \mathfrak{a} r_1 - \int_{t_1}^0 \delta V(\mathbf{r}(t)) dt. \quad (2.7)$$

Здесь $\eta = Z / \mathfrak{a}$ — параметр Зоммерфельда, $\mathbf{r}(t)$ — подбарьерная траектория с мнимым временем, $r_1 = [\mathbf{r}^2(t_1)]^{1/2}$ — точка сшивания и δV — возмущающий потенциал, в данном случае $\delta V(r) = -Z / r$. Из (2.3) находим:

$$r(t) \equiv (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{T}{\omega^2} \cdot \xi(\tau), \quad (2.8)$$

$$\xi(\tau) = \left\{ \frac{1}{4} (\tau_0^2 - \tau^2)^2 \cos^2 \alpha + \tau_0^2 \left[\left(\frac{\text{ch} \tau_0 - \text{ch} \tau}{\text{sh} \tau_0} \right)^2 - \left(\frac{\text{sh} \tau}{\text{sh} \tau_0} - \frac{\tau}{\tau_0} \right)^2 \right] \sin^2 \alpha \right\}^{1/2}, \quad (2.8')$$

что при $\tau \rightarrow -\tau_0$ дает:

$$\xi(\tau) = \gamma \Delta\tau - \frac{1}{2} s (\Delta\tau)^2 + \mathbf{K}, \quad s = \tau_0 / \gamma \quad (2.9)$$

($\Delta\tau = \tau + \tau_0 \rightarrow 0$), или

$$r(t) = i\mathfrak{a}(t - t_0) + \frac{1}{2} s T (t - t_0)^2 + \mathbf{K} \quad (2.9')$$

⁵⁾ Ñĭ. ĭðĕĕĭæĭĕâ, â òâĕæâ âĭâĕĭĕâĕĭĭâ ðâññĭĭððâĭĕâ äĕÿ àòĭĭâ âĭâĭðĭĕâ â ýĕâĕððĕâñĕĭĭ ĭĕâ [].

(Последняя формула соответствует тому, что начальная скорость частицы равна $i\alpha$, т. е. является чисто мнимой). Подставляя (2.8), (2.9) в (2.7) и переходя к пределу $\tau_1 \rightarrow -\tau_0$ (при этом точка сшивания выпадает из ответа), находим кулоновскую поправку к действию:

$$\delta S = -i\eta \left\{ \ln \left(\frac{\alpha^3}{T} s \right) + \int_{-\tau_0}^0 d\tau \left[\frac{\gamma}{\xi(\tau)} - \frac{1}{\tau_0 + \tau} \right] \right\}, \quad (2.10)$$

что в итоге дает следующий фактор в вероятности ионизации:

$$C(T, Y) = \left\{ \frac{2T_0}{T} \Phi(\gamma, \alpha) \right\}^{2\eta}, \quad (2.11)$$

$$\Phi(\gamma, \alpha) = \ln \frac{s}{2} + \int_0^{\tau_0} d\tau \left[\frac{\gamma}{\xi(\tau)} - \frac{1}{\tau_0 - \tau} \right]. \quad (2.11')$$

Для удобства вычислений мы здесь изменили знак у переменной τ , воспользовавшись тем, что $\xi(\tau)$ — четная функция. Из (2.9) видно, что интеграл в (2.11') не содержит расходимости на верхнем пределе, и легко может быть найден численно. Результаты расчета представлены на рис. 1.

Заметим, что при выключении магнитного поля $\gamma = 0$, $s \equiv 1$,

$\xi(\tau) = \frac{1}{2}(\tau_0^2 - \tau^2)$ и $\Phi(0, \alpha) = 0$. При этом формула (2.11) сводится

к известной кулоновской поправке для чисто электрического поля [].

Рассмотрим еще случай слабого магнитного поля. Разложение (2.8') при $\tau, \tau_0 \sim \gamma \rightarrow 0$ дает:

$$\begin{aligned} \xi(\tau) &= \frac{1}{2}(\tau_0^2 - \tau^2) \left[1 - \frac{\sin^2 \alpha}{36} (3\tau_0^2 - \tau^2) + K \right] = \\ &= \frac{\gamma}{2\tau_0} (\tau_0^2 - \tau^2) - \frac{\sin^2 \alpha}{72} (\tau_0^2 - \tau^2)^2 + K, \end{aligned}$$

откуда

$$\varphi(\gamma, \alpha) = \frac{1}{9} \sin^2 \alpha \cdot \gamma^2 + O(\gamma^4), \quad \gamma \ll 1. \quad (2.12)$$

§3. Ионизация в слабом поле и поведение высших порядков теории возмущений

При расчете уровней энергии атома в электрическом поле стандартным подходом является разложение энергии в ряд ТВ

$$E = \sum_{k=0}^{\infty} E_k T^k. \quad (3.1)$$

Согласно аргументу Дайсона, нестабильность состояния в сколь угодно слабом поле приводит к расходимости ряда ТВ. Здесь мы изучим поведение высших порядков ТВ E_k в присутствии произвольно направленного магнитного поля $Y = \gamma T$. Этот вопрос интересен с общей точки зрения, а также важен при использовании

специальных процедур суммирования расходящихся рядов, таких как метод Бореля.

Для оценки поведения E_k используем, как обычно [4 - 6], дисперсионные соотношения:

$$E_k = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{E(\Gamma)}{\Gamma^{k+1}} d\Gamma, \tag{3.2}$$

где интегрирование ведется по малой окружности, охватывающей точку $\Gamma = 0$. Некоторые предположения относительно аналитических свойств функции $E(\Gamma)$ (см., например, [4]) позволяют при достаточно больших k преобразовать (3.2) к виду:

$$E_k = \frac{-1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\Gamma(\Gamma)}{\Gamma^{k+1}} d\Gamma. \tag{3.3}$$

Подставляя сюда квазиклассическую формулу (2.5) для ширины $\Gamma = \hbar w$, находим:

$$E_k \sim C a^k k^\beta k!, \tag{3.4}$$

где C , a и β — параметры асимптотики. Наиболее существенный параметр a , которым мы здесь и ограничимся, обратно пропорционален действию вдоль подбарьерной траектории:

$$a = \frac{3}{2\Gamma_0} g^{-1}(\gamma, \alpha), \tag{3.5}$$

Асимптотика (3.4) записана без учета вклада от второй подбарьерной траектории, отвечающей отрицательному корню уравнения (2.4) $\tau_0^{(-)} = -\tau_0$ и функции $g^{(-)}(\gamma, \alpha) = -g(\gamma, \alpha)$. С учетом второго решения $a^{(-)} = -a$ эта асимптотика принимает вид:

$$E_k \sim Ca^k k^\beta k! + Ca^{(-)k} k^\beta k! = [1 + (-)^k] Ca^k k^\beta k!, \quad (3.6)$$

Это согласуется с тем, что энергия является четной функцией напряженности электрического поля и нечетные порядки ТВ обращаются в нуль. В дальнейшем будем рассматривать лишь четные порядки ТВ, опуская множитель $[1 + (-)^k]$ в асимптотике.

Далее для упрощения формул рассмотрим только основное состояние атома водорода, когда $T_0 = Y_0 = \alpha = 1$ (общий случай сводится к водородному простым масштабированием).

При выключении магнитного поля $a = 3/2$ в согласии с известным результатом для эффекта Штарка [5]:

$$E_k \sim -\frac{6}{\pi} \left(\frac{3}{2}\right)^k k! \quad (3.7)$$

(основное состояние).

Наряду со штарковским разложением (3.1) рассмотрим разложение по Y :

$$E = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{E}_k Y^k, \quad (3.8)$$

где $\tilde{E}_k = \gamma^{-k} E_k$. В случае эффекта Зеемана ($\gamma \rightarrow \infty$) высшие порядки в разложении (3.8) также факториально растут [6]:

$$\tilde{E}_k \sim -(-)^{k/2} \left(\frac{4}{\pi}\right)^{5/2} \left(\frac{1}{\pi}\right)^k k^{1/2} k!, \quad (3.9)$$

что формально отвечает асимптотике вида

$$\tilde{E}_k \sim C \tilde{a}^k k^\beta k! \quad (3.10)$$

с мнимым параметром

$$\tilde{a} = a/\gamma = \pm(\pi i)^{-1}. \quad (3.11)$$

В то же время при больших γ в силу (2.6") и (3.5) имеем:

$$\tilde{a} = \frac{3}{2\gamma} g^{-1}(\gamma, \alpha) = \frac{3}{2\gamma} |\cos \alpha| \rightarrow 0 \quad (3.12)$$

в противоречии с формулой (3.11). Это наводит на мысль о существовании других (комплексных) подбарьерных траекторий, для которых величина \tilde{a} не исчезает в пределе сильных магнитных полей. Ниже мы покажем, решая уравнение (2.4) при больших γ в комплексных числах, что это действительно так.

Вводя обозначения $\tau_0 = i\tilde{\tau}_0$ и $\gamma = i\tilde{\gamma}$, перепишем уравнение (2.4)

в виде:

$$\tilde{\tau}_0^2 + \sin^2 \alpha (\tilde{\tau}_0 \operatorname{ctg} \tilde{\tau}_0 - 1)^2 = \tilde{\gamma}^2. \quad (3.13)$$

Решение, конечное при $\tilde{\gamma} \rightarrow \infty$, имеет вид:

$$\begin{aligned} \tilde{\tau}_0 = N\pi + N\pi \sin \alpha \cdot \tilde{\gamma}^{-1} + \frac{1}{2} N^3 \pi^3 \sin \alpha \left(1 - \frac{2}{3} \sin^2 \alpha \right) \cdot \tilde{\gamma}^{-3} + \\ + N^3 \pi^3 \sin^2 \alpha \left(1 - \frac{1}{3} \sin^2 \alpha \right) \tilde{\gamma}^{-4} + \frac{1}{2} N^5 \pi^5 \sin \alpha \left(\frac{\sin^2 \alpha}{N^2 \pi^2} + \frac{3}{4} - \sin^2 \alpha + \frac{2}{5} \sin^4 \alpha \right) \tilde{\gamma}^{-5} \\ + 2N^5 \pi^5 \sin^2 \alpha \left(\cos^2 \alpha - \frac{4}{15} \sin^4 \alpha \right) \tilde{\gamma}^{-6} + \mathbf{K}, \end{aligned} \quad (3.14)$$

где $N = 1, 2, \mathbf{K}$, причем $\tilde{\tau}_0^*$, $-\tilde{\tau}_0$ и $-\tilde{\tau}_0^*$ — также решения уравнения (3.13).

Введем далее функцию

$$G(\gamma, \alpha) = \frac{2\tilde{\gamma}}{3\pi} g(\gamma, \alpha) = \frac{2\tilde{\tau}_0^3}{3\pi\tilde{\gamma}^2} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \sin^2 \alpha [1 + 3 \operatorname{ctg} \tilde{\tau}_0 (\operatorname{ctg} \tilde{\tau}_0 - 1 / \tilde{\tau}_0)] \right\}. \quad (3.15)$$

Подставляя разложение (3.14) в (3.15), находим

$$\begin{aligned} G(\gamma, \alpha) = N - 2N \sin \alpha \cdot \tilde{\gamma}^{-1} + \left(N \sin^2 \alpha - \frac{1}{3} N^3 \pi^2 \cos^2 \alpha \right) \tilde{\gamma}^{-2} + \\ + N^3 \pi^2 \left(\frac{2}{3} \sin^2 \alpha - 1 \right) \sin \alpha \cdot \tilde{\gamma}^{-3} + N^3 \pi^2 \sin^2 \alpha \left(\frac{1}{3} \sin^2 \alpha - 1 \right) \tilde{\gamma}^{-4} + \\ + N^3 \pi^2 \sin \alpha \left(-\frac{2}{15} N^2 \pi^2 \sin^4 \alpha + \frac{1}{3} N^2 \pi^2 \sin^2 \alpha - \frac{1}{4} N^2 \pi^2 - \frac{1}{3} \sin^2 \alpha \right) \tilde{\gamma}^{-5} + \mathbf{K}, \end{aligned} \quad (3.16)$$

где $N = 1, 2, K$. Нас будет интересовать только случай $N = 1$, когда функция $G(\gamma, \alpha)$ минимальна по модулю. Соответствующие функции $g_c(\gamma, \alpha) = (3\pi / 2\tilde{\gamma})G(\gamma, \alpha)$ изображены (по модулю) на рис. 1 штриховыми линиями. В области достаточно больших γ , когда $|g_c|$ меньше g , параметр асимптотики a находится по формуле (3.5) с заменой g на g_c . Из-за существования комплексно-сопряженных решений асимптотика коэффициентов ТВ имеет более сложную форму:

$$\tilde{E}_k \sim (-1)^{k/2} \operatorname{Re}(CA^k) k^\beta k!, \quad A = i\tilde{a} = [\pi G(\gamma, \alpha)]^{-1}. \quad (3.17)$$

Графики вещественной и мнимой частей функции $G(\gamma, \alpha)$ при различных α даны на рис. 3.

В пределе $\alpha \rightarrow 0$ (параллельные поля) разложение (3.16) обрывается на третьем члене. Имеем:

$$G(\gamma, 0) = 1 + \frac{\pi^2}{3\gamma^2}. \quad (3.18)$$

Ряд ТВ при этом является знакопеременным. Однако в достаточно сильном электрическом поле, когда

$$\gamma < \gamma_c = \pi \left[(1 + \sqrt{2})^{1/3} - (1 + \sqrt{2})^{-1/3} \right]^{-1} \approx 5,2705, \quad (3.19)$$

доминирующий вклад дает подбарьерная траектория с вещественным τ_0 (отвечающая $g(\gamma, 0) = 1$), и ряд ТВ знакпостоянен.

Таким образом, для параллельных полей

$$E_k \sim - \left[C_0 \frac{6}{\pi} \left(\frac{3}{2} \right)^k + (-)^{k/2} C_1 \left(\frac{4}{\pi} \right)^{5/2} \left(\frac{\pi}{\gamma} + \frac{\pi^3}{3\gamma^3} \right)^{-k} k^{1/2} \right] k!, \quad (3.20)$$

где множители C_0 и C_1 — некоторые функции γ . Они могут быть найдены численно, исходя из нескольких десятков коэффициентов ТВ E_k . Не вдаваясь здесь в детали расчета, приведем графики C_0 и C_1 на рис. **Fehler! Textmarke nicht definiert.** При малых γ

$$C_0 \sim 1 - \frac{1}{6}\gamma^2 + \frac{7}{360}\gamma^4 - 0,00205\gamma^6 + \mathbf{K}, \quad (3.21)$$

а при больших γ

$$C_1 \sim 1 - 12,03\gamma^{-2} + \mathbf{K}. \quad (3.22)$$

Приложение А

Уравнение (2.4) определяет начальный момент подбарьерного движения. Приведем некоторые асимптотики. При $\gamma \ll 1$:

$$s(\gamma, \alpha) = \frac{\tau_0}{\gamma} = 1 + \frac{\sin^2 \alpha}{18} \gamma^2 + \left(\frac{7 \sin^4 \alpha}{648} - \frac{\sin^2 \alpha}{135} \right) \gamma^4 + \\ + \left(\frac{11 \sin^6 \alpha}{3888} - \frac{\sin^4 \alpha}{270} + \frac{\sin^2 \alpha}{1050} \right) \gamma^6 + K. \quad (A.1)$$

В другом предельном случае ($\gamma \gg 1$) уравнение (2.4) принимает вид:

$$\tau_0^2 - (\tau_0 - 1)^2 \sin^2 \alpha + O(e^{-2\tau_0}) = \gamma^2, \text{ откуда}$$

$$\tau_0 = -\operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{\gamma}{|\cos \alpha|} (1 + \gamma^{-2} \operatorname{tg}^2 \alpha)^{1/2} + O(\gamma \exp(-2\gamma/|\cos \alpha|)) = \\ = \frac{\gamma}{|\cos \alpha|} - \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{\operatorname{tg}^2 \alpha}{2|\cos \alpha|} \cdot \gamma^{-1} + K \quad (A.2)$$

Подставляя эти разложения в (2.6), приходим к формулам (2.6') и (2.6").

В случае $\alpha = \pi/2$ (перпендикулярные поля) формулы (A.2) и (2.6") неприменимы. Соответствующие разложения при $\gamma \rightarrow \infty$ имеют вид

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{1}{2} [\gamma + \gamma^{-1} + \gamma^3 \exp(-\gamma^2) + K], \\
 g &= \frac{3}{8} \gamma [(1 + \gamma^{-2})^2 - 2 \exp(-\gamma^2) + K].
 \end{aligned}
 \tag{A.3}$$

Таким образом, функция $g(\gamma, \pi/2)$ при $\gamma \gg 1$ возрастает линейно (что согласуется с рис. 1), а вероятность ионизации обращается в нуль при $Y \rightarrow \infty$:

$$w \propto \exp \left\{ -\frac{1}{4} \left[\frac{\omega}{\varepsilon^2} \varepsilon^{-2} + 2 \frac{\varepsilon^2}{\omega} + K \right] \right\},
 \tag{A.4}$$

где $\varepsilon = T/T_0$ (чисто магнитное поле не ионизует связанный уровень).

Литература

1. Первая ссылка
- 2.
- 3.
4. С. М. Bender, Т. Т. Wu, Phys. Rev. D, 7, 1620, 1973.
5. Н. J. Silverstone. Phys. Rev. Lett., 43, 1498, 1979.
6. J. E. Avron, Ann. Phys. (N. Y.), 131, 79, 1981.
- 7.
- 8.

Подписи к рисункам

Рисунок 1. Функции $g(\gamma, \alpha)$...

Рисунок 2. Функции $\varphi(\gamma, \alpha)$...

Рисунок 3. Функции $G(\gamma, \alpha)$...